



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111370562 A

(43)申请公布日 2020.07.03

(21)申请号 202010192661.4

(22)申请日 2020.03.18

(71)申请人 京东方科技集团股份有限公司  
地址 100015 北京市朝阳区酒仙桥路10号  
申请人 北京京东方光电科技有限公司

(72)发明人 纪翔宇 董恩凯 李召辉 陈振彰  
杨威 李沛 翟明

(74)专利代理机构 北京同达信恒知识产权代理  
有限公司 11291  
代理人 刘源

(51)Int.Cl.  
H01L 33/62(2010.01)  
H01L 21/683(2006.01)

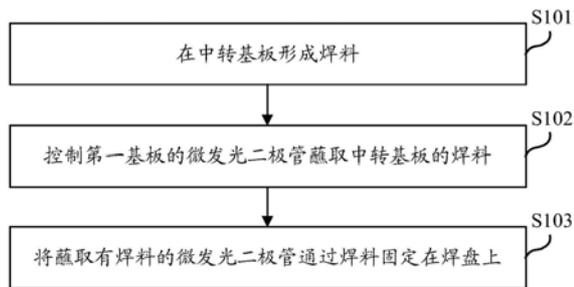
权利要求书2页 说明书6页 附图5页

(54)发明名称

一种微发光二极管的转印方法及微发光二  
极管显示面板

(57)摘要

本发明公开了一种微发光二极管的转印方  
法及微发光二极管显示面板,以改善现有技术通  
过钢网印刷方式制作微发光二极管时,存在制作  
较大尺寸的钢网较难,网孔尺寸较难控制,印刷  
偏位,以及容易存现爆灯的问题。所述转印方法,  
包括:在中转基板形成焊料;控制第一基板的微  
发光二极管蘸取所述中转基板的所述焊料;将蘸  
取有所述焊料的所述微发光二极管通过所述焊  
料固定在焊盘上。



1. 一种微发光二极管的转印方法,其特征在于,包括:  
在中转基板形成焊料;  
控制第一基板的微发光二极管蘸取所述中转基板的所述焊料;  
将蘸取有所述焊料的所述微发光二极管通过所述焊料固定在焊盘上。
2. 如权利要求1所述的转印方法,其特征在于,所述在中转基板形成焊料,包括:  
在所述中转基板通过丝网印刷工艺形成所述焊料。
3. 如权利要求2所述的转印方法,其特征在于,所述在所述中转基板通过丝网印刷工艺形成所述焊料,包括:  
在所述中转基板通过丝网印刷工艺形成助焊剂或者锡膏。
4. 如权利要求1所述的转印方法,其特征在于,所述控制第一基板的微发光二极管蘸取所述中转基板的所述焊料,包括:  
将形成有所述微发光二极管的所述第一基板置于与所述中转基板相对的位置;  
通过滚轮按压所述第一基板以使所述微发光二极管与所述焊料接触。
5. 如权利要求1所述的转印方法,其特征在于,所述控制第一基板的微发光二极管蘸取所述中转基板的所述焊料,包括:  
将形成有所述微发光二极管的第一基板安插在蘸取装置的插槽中,其中,所述蘸取装置包括:基台,与所述基台固定的承载台、升降台,以及与所述升降台固定的压头,所述升降台具有镂空部以及位于所述镂空部周边的插槽,所述承载台用于放置活动焊料槽;  
调整所述蘸取装置的所述压头压在所述第一基板中形成有所述微发光二极管的区域;  
控制所述蘸取装置的所述升降台和所述压头一体向所述承载台一侧移动,以与放置于所述承载台的所述焊料槽中的焊料接触,以使所述微发光二极管蘸取所述焊料。
6. 如权利要求5所述的转印方法,其特征在于,所述蘸取装置还包括:多个升降杆,所述升降杆沿垂直于所述基台方向伸缩时,带动所述升降台相对所述基台移动;  
所述控制所述蘸取装置的所述升降台和所述压头一体向所述承载台一侧移动,包括:  
通过控制所述升降杆向所述承载台一侧移动,以带动所述升降台和所述压头一体向所述承载台一侧移动。
7. 如权利要求5所述的转印方法,其特征在于,在控制所述蘸取装置的所述升降台和所述压头一体向所述承载台一侧移动,以与放置于所述承载台的所述焊料槽中的焊料接触,以使所述微发光二极管蘸取所述焊料之后,以及在将蘸取有所述焊料的所述微发光二极管通过所述焊料固定在焊盘上之前,所述转印方法还包括:  
控制所述蘸取装置的所述升降台和所述压头一体向远离所述承载台一侧移动;  
将所述第一基板从所述插槽中取出。
8. 如权利要求1所述的转印方法,其特征在于,在中转基板形成焊料之前,所述制作方法还包括:  
在所述微发光二极管的具有电极的表面形成共晶材料,并与蓝膜衬底贴合;  
将所述蓝膜衬底上的所述微发光二极管转移到紫外衬底膜;  
对形成有所述微发光二极管的所述紫外衬底膜进行扩晶工艺。
9. 如权利要求8所述的转印方法,其特征在于,在将蘸取有所述焊料的所述微发光二极管通过所述焊料固定在焊盘上之前,所述转印方法还包括:

对形成有驱动电路的焊盘进行化金工艺。

10. 一种微发光二极管显示面板,其特征在于,所述微发光二极管显示面板采用包括根据权利要求1-9任一项所述的转印方法制得。

## 一种微发光二极管的转印方法及微发光二极管显示面板

### 技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种微发光二极管的转印方法及微发光二极管显示面板。

### 背景技术

[0002] 随着微发光二极管(包括:MiniLED以及MicroLED)面光源的横空出世,为了最大限度增加高动态光照渲染,提高对比度和卓越的色彩表现力。针对于现有MiniLED的制作工艺是主要是钢网印刷锡膏的方式,该种钢网印刷锡膏的方式制作中小尺寸的基板极其广泛,并且具有很好的量产性。

[0003] 但是制作大尺寸基板,钢网印刷的方式存在很多的不足,例如,现有技术较难制作大尺寸微发光二极管显示产品所需要的钢网(即,对应需要较大尺寸的钢网,大尺寸的钢网较难制作),且制作大尺寸微发光二极管显示产品时,钢网的网孔较多,较难控制各网孔的尺寸均一性,进而会导致最终印刷偏位的问题,且钢网材质较硬,在转印到玻璃材质的显示面板的衬底基板时,容易导致玻璃基板上的线路断裂,造成线路短路,进而出现微发光二极管的爆灯现象。

### 发明内容

[0004] 本发明提供一种微发光二极管的转印方法及微发光二极管显示面板,以改善现有技术通过钢网印刷方式制作微发光二极管时,存在制作较大尺寸的钢网较难,网孔尺寸较难控制,印刷偏位的问题,以及容易存现爆灯的问题。

[0005] 本发明实施例提供一种微发光二极管的转印方法,包括:

[0006] 在中转基板形成焊料;

[0007] 控制第一基板的微发光二极管蘸取所述中转基板的所述焊料;

[0008] 将蘸取有所述焊料的所述微发光二极管通过所述焊料固定在焊盘上。

[0009] 在一种可能的实施方式中,所述在中转基板形成焊料,包括:

[0010] 在所述中转基板通过丝网印刷工艺形成所述焊料。

[0011] 在一种可能的实施方式中,所述在所述中转基板通过丝网印刷工艺形成所述焊料,包括:

[0012] 在所述中转基板通过丝网印刷工艺形成助焊剂或者锡膏。

[0013] 在一种可能的实施方式中,所述控制第一基板的微发光二极管蘸取所述中转基板的所述焊料,包括:

[0014] 将形成有所述微发光二极管的所述第一基板置于与所述中转基板相对的位置;

[0015] 通过滚轮按压所述第一基板以使所述微发光二极管与所述焊料接触。

[0016] 在一种可能的实施方式中,所述控制第一基板的微发光二极管蘸取所述中转基板的所述焊料,包括:

[0017] 将形成有所述微发光二极管的第一基板安插在蘸取装置的插槽中,其中,所述蘸

取装置包括:基台,与所述基台固定的承载台、升降台,以及与所述升降台固定的压头,所述升降台具有镂空部以及位于所述镂空部周边的插槽,所述承载台用于放置活动焊料槽;

[0018] 调整所述蘸取装置的所述压头压在所述第一基板中形成有所述微发光二极管的区域;

[0019] 控制所述蘸取装置的所述升降台和所述压头一体向所述承载台一侧移动,以与放置于所述承载台的所述焊料槽中的焊料接触,以使所述微发光二极管蘸取所述焊料。

[0020] 在一种可能的实施方式中,所述蘸取装置还包括:多个升降杆,所述升降杆沿垂直于所述基台方向伸缩时,带动所述升降台相对所述基台移动;

[0021] 所述控制所述蘸取装置的所述升降台和所述压头一体向所述承载台一侧移动,包括:通过控制所述升降杆向所述承载台一侧移动,以带动所述升降台和所述压头一体向所述承载台一侧移动。

[0022] 在一种可能的实施方式中,在控制所述蘸取装置的所述升降台和所述压头一体向所述承载台一侧移动,以与放置于所述承载台的所述焊料槽中的焊料接触,以使所述微发光二极管蘸取所述焊料之后,以及在将蘸取有所述焊料的所述微发光二极管通过所述焊料固定在焊盘上之前,所述转印方法还包括:

[0023] 控制所述蘸取装置的所述升降台和所述压头一体向远离所述承载台一侧移动;

[0024] 将所述第一基板从所述插槽中取出。

[0025] 在一种可能的实施方式中,在中转基板形成焊料之前,所述制作方法还包括:

[0026] 在所述微发光二极管的具有电极的表面形成共晶材料,并与蓝膜衬底贴合;

[0027] 将所述蓝膜衬底上的所述微发光二极管转移到紫外衬底膜;

[0028] 对形成有所述微发光二极管的所述紫外衬底膜进行扩晶工艺。

[0029] 在一种可能的实施方式中,在将蘸取有所述焊料的所述微发光二极管通过所述焊料固定在焊盘上之前,所述转印方法还包括:

[0030] 对形成有驱动电路的焊盘进行化金工艺。

[0031] 本发明实施例还提供一种微发光二极管显示面板,所述微发光二极管显示面板采用包括根据本发明实施例提供的所述转印方法制得。

[0032] 本发明实施例有益效果如下:本发明实施例提供的微发光二极管的转印方法,包括:在中转基板形成焊料;控制第一基板的微发光二极管蘸取所述中转基板的所述焊料;将蘸取有所述焊料的所述微发光二极管通过所述焊料固定在焊盘上,即,本发明实施例在转印微发光二极管时,先将焊料制作在中转基板上,再使微发光二极管蘸取中转基板上的焊料,最后再将蘸有焊料的微发光二极管固定在焊盘上,相比于现有技术,本发明实施例在转印微发光二极管时,通常需要先通过钢网在焊盘上制作焊料,再将微发光二极管转印到形成有焊料的焊盘上,本发明实施例并不需要通过钢网在焊盘上制作焊料,进而可以改善现有技术通过钢网印刷方式制作微发光二极管时,存在制作较大尺寸的钢网较难,网孔尺寸较难控制,进而会导致最终印刷偏位的问题,以及容易存现爆灯的问题。

## 附图说明

[0033] 图1为现有技术的微发光二极管的转移流程示意图;

[0034] 图2为本发明实施例提供的一种微发光二极管的转印方法流程图;

- [0035] 图3为本发明实施例提供的一种具体的微发光二极管的转印方法流程图；
- [0036] 图4为本发明实施例提供的另一种具体的微发光二极管的转印方法流程图；
- [0037] 图5为本发明实施例提供的微发光二极管的转印流程示意图；
- [0038] 图6为推力测试示意图；
- [0039] 图7为本发明实施例提供的一种蘸取装置下降前的结构示意图；
- [0040] 图8为本发明实施例提供的一种蘸取装置下降后的结构示意图。

### 具体实施方式

[0041] 为了使得本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本公开实施例的附图，对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本公开的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例，本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本公开保护的范畴。

[0042] 除非另外定义，本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性，而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同，而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接，而是可以包括电性的连接，不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系，当被描述对象的绝对位置改变后，则该相对位置关系也可能相应地改变。

[0043] 为了保持本公开实施例的以下说明清楚且简明，本公开省略了已知功能和已知部件的详细说明。

[0044] 参见图1所示，为传统的微发光二极管的转印工艺流程，包括：

[0045] 步骤a，对形成有微发光二极管的Pad的具有微发光二极管电极的表面（即图1中的a图中的微发光二极管的下表面）覆盖SnAg共晶材料，并使微发光二极管具有电极的表面与蓝膜衬底进行贴合；

[0046] 步骤b，将蓝膜衬底上的微发光二极管转印到紫外衬底膜（UV膜）上；

[0047] 步骤c，对形成有微发光二极管的紫外衬底膜进行扩晶；

[0048] 步骤e，对形成有驱动电路的焊盘进行化金工艺；

[0049] 步骤f，利用钢网将阻焊剂印刷到焊盘上；

[0050] 步骤g，将扩晶后的紫外衬底膜上微发光二极管固定在焊盘上。

[0051] 通过以上工艺流程转印微发光二极管，需要利用钢网将阻焊剂印刷到焊盘上，进而制作大尺寸微发光二极管显示产品时，需要较大尺寸的钢网，而较大尺寸的钢网存在制作困难，以及钢网的网孔较多，较难控制各网孔的尺寸均一性，进而会导致最终印刷偏位的问题，且在焊盘的衬底基板为玻璃基板时，由于钢网材质较硬，在转印时，容易导致玻璃基板上的线路断裂，造成线路短路，进而最终出现制作在玻璃衬底基板上的微发光二极管会存现爆灯现象。

[0052] 基于以上问题，参见图2，本发明实施例提供一种微发光二极管的转印方法，包括：

[0053] 步骤S101、在中转基板形成焊料。具体的,焊料在中转基板上可以为一整层,且各个位置厚度均匀的面状分布。焊料具体可以为阻焊剂或者锡膏。

[0054] 步骤S102、控制第一基板的微发光二极管蘸取中转基板的焊料。第一基板具体可以为形成有微发光二极管的紫外衬底膜(UV膜)。

[0055] 步骤S103、将蘸取有焊料的微发光二极管通过焊料固定在焊盘上。

[0056] 本发明实施例提供的微发光二极管的转印方法,包括:在中转基板形成焊料;控制第一基板的微发光二极管蘸取中转基板的焊料;将蘸取有焊料的微发光二极管通过焊料固定在焊盘上,即,本发明实施例在转印微发光二极管时,先将焊料制作在中转基板上,再使微发光二极管蘸取中转基板上的焊料,最后再将蘸有焊料的微发光二极管固定在焊盘上,相比于现有技术转印微发光二极管时,通常需要先焊盘上通过钢网印刷焊料,再将微发光二极管转印到形成有焊料的焊盘上,本发明实施例并不需要通过钢网在焊盘上制作焊料,进而可以改善现有技术通过钢网印刷方式制作微发光二极管时,存在制作较大尺寸的钢网较难,网孔尺寸较难控制,进而会导致最终印刷偏位的问题,以及容易存现爆灯的问题。

[0057] 在具体实施时,结合图3所示,在步骤S101之前,即,在中转基板形成焊料之前,制作方法还包括:

[0058] 步骤S104、在微发光二极管的具有电极的表面形成共晶材料,并与蓝膜衬底贴合;

[0059] 步骤S105、将蓝膜衬底上的微发光二极管转移到紫外衬底膜;

[0060] 步骤S106、对形成有微发光二极管的紫外衬底膜进行扩晶工艺。

[0061] 在具体实施时,结合图4所示,在步骤S103之前,即,在将蘸取有焊料的微发光二极管通过焊料固定在焊盘上之前,转印方法还包括:

[0062] 步骤S107、对形成有驱动电路的焊盘进行化金工艺。

[0063] 在具体实施时,可以通过丝网印刷工艺在中转基板上形成焊料,即,关于步骤S101、在中转基板形成焊料,具体可以包括:在中转基板通过丝网印刷工艺形成焊料。具体的,焊料的材质具体可以为阻焊剂或者锡膏,即,在中转基板通过丝网印刷工艺形成焊料,包括:在中转基板通过丝网印刷工艺形成助焊剂或者锡膏。本发明实施例中,在中转基板通过丝网印刷工艺形成焊料,可以在中转基板上形成各个位置厚度分布较为均匀的焊料,避免厚度分布不均匀时,会导致后续在将微发光二极管转移到焊盘时,会存在由于焊料较厚的位置较难将微发光二极管转移到焊盘的问题。当然,在具体实施时,还可以通过其它方式将焊料形成在中转基板上。

[0064] 在具体实施时,可以通过滚轮压制实现将紫外衬底膜上的微发光二极管与中转基板上的焊料接触,即,关于步骤S102,控制第一基板的微发光二极管蘸取中转基板的焊料,包括:

[0065] 步骤S1021、将形成有微发光二极管的第一基板置于与中转基板相对的位置;

[0066] 步骤S1022、通过滚轮按压第一基板以使微发光二极管与焊料接触。具体的,滚轮可以为手动滚轮。

[0067] 本发明实施例中,通过滚轮按压实现使微发光二极管蘸取焊料,具有操作简单,易于实现的优势。

[0068] 为了更清楚地理解本发明实施例提供的微发光二极管的制作方法,以下结合图5

对本发明实施例提供的转印方法进行进一步详细说明如下：

[0069] 步骤a,在微发光二极管的具有电极的表面形成SnAg共晶材料,并与蓝膜衬底贴合。

[0070] 步骤b,将蓝膜衬底上的微发光二极管转移到UV膜,该UV膜可以后续在设定条件下发生变化,以使其上的微发光二极管与UV膜脱离。

[0071] 步骤c,对形成有微发光二极管的UV膜进行扩晶工艺,即,对微发光二极管之间的间距进行拉伸,以与后续焊盘上的驱动电路对应。具体的扩晶工艺可以与现有技术的扩晶工艺相同,本发明在此不再赘述。

[0072] 步骤d,在中转基板通过丝网印刷工艺形成助焊剂或者锡膏。

[0073] 步骤e,将形成有微发光二极管的UV膜置于与中转基板相对的位置,并通过滚轮按压UV膜的背离微发光二极管的一面,以使微发光二极管与中转基板上的焊料接触。

[0074] 步骤f,对形成有驱动电路的焊盘进行化金工艺,即,形成与微发光二极管对应的连接电极。具体的焊盘化金工艺可以与现有技术的焊盘化金工艺相同,本发明在此不再赘述。

[0075] 步骤g,将蘸取有焊料的微发光二极管通过焊料固定在焊盘上。具体的,可以通过固金工艺的设备,例如,该设备可以包括具有尖端的按压部件,将UV膜上的微发光二极管按压到焊盘上,并进行焊接。

[0076] 图6为推力测试时的对比示意图,其中,S1为通过现有技术的钢网印刷工艺形成的微发光二极管在进行推力测试时的折线图,S2为通过本发明实施例提供的转印方法形成的微发光二极管在进行推力测试时的折线图,其中,横坐标表示受测试的微发光二极管的个数,纵坐标表示推动该微发光二极管时所需要的推力,由S1和S2的对比可知,本发明实施例提供的转印方法获得的微发光二极管的固定效果更佳。

[0077] 在具体实施时,考虑到滚轮影响蘸取焊料的均匀性,同时手动分离形成有微发光二极管的紫外衬底膜与中转基板时,由于受力不均会影响蘸取焊料的均匀性,进而导致焊料印刷到中转基板再转到芯片方案存在漏固(即,焊料厚的位置处的微发光二极管较难转到焊盘上)问题。针对以上问题本发明实施例还提供一种蘸取装置,参见图7和图8所示,其中,图7为蘸取装置下降前的示意图,图8为下降后的示意图,蘸取装置包括:基台1,与基台1固定的承载台2、升降台3,以及与升降台3固定的压头4,升降台3具有镂空部31以及位于镂空部31周边的插槽32,其中,形成有微发光二极管的第一基板7可以安插在插槽中,承载台2用于放置活动焊料槽5,即,焊料槽5可以从承载台2取下或放上,压头4具体可以通过压力手柄41进行上下移动调整。焊料槽5装有助焊剂,可以通过刮板手动均匀挂平助焊剂,其中焊料槽5可以具有凹槽,凹槽的深度可以为30um~50um;插槽32可以安插具有微发光二极管的UV膜(wafer,也即第一基板),通过压力手柄41调节压头4,对UV膜的具有微发光二极管的区域施加一定的压力,同时保证芯片区域的平整性;通过电控方式使升降台3下降蘸取助焊剂,再上升分离来完成助焊剂转移。

[0078] 具体可以通过上述蘸取装置实现将紫外衬底膜上的微发光二极管与中转基板上的焊料接触,即,关于步骤S102,控制第一基板的微发光二极管蘸取中转基板的焊料,包括:

[0079] S1023、将形成有微发光二极管的第一基板安插在蘸取装置的插槽32中;

[0080] S1024、调整蘸取装置的压头4压在第一基板中形成有微发光二极管的区域;

[0081] S1025、控制蘸取装置的升降台3和压头4一体向承载台2一侧移动,以与放置于承载台2的焊料槽5中的焊料接触,以使微发光二极管蘸取焊料。

[0082] 本发明实施例中,通过本发明实施例提供的蘸取装置使微发光二极管蘸取焊料时,可以改善微发光二极管蘸取焊料时,存在蘸取不均匀,进而最终存现漏固的问题。

[0083] 在具体实施时,结合图5所示,蘸取装置还包括:多个升降杆6,升降杆6沿垂直于基台1方向伸缩时,带动升降台3相对基台1移动;相应的,控制蘸取装置的升降台6和压头一体向承载台2一侧移动,包括:通过控制升降杆6下移,以带动升降台3和压头4一体向承载台2一侧移动。

[0084] 在具体实施时,在步骤S1025之后,以及在步骤S103之前,即,在控制蘸取装置的升降台3和压头4一体下移向承载台2一侧移动,以与放置于承载台2的焊料槽5中的焊料接触,以使微发光二极管蘸取焊料之后,以及在将蘸取有焊料的微发光二极管通过焊料固定在焊盘上之前,转印方法还包括:

[0085] 步骤S1026、控制蘸取装置的升降台3和压头4一体向远离承载台一侧移动;

[0086] 步骤S1027、将第一基板从插槽32中取出。

[0087] 本发明实施例还提供一种微发光二极管显示面板,微发光二极管显示面板采用包括根据本发明实施例提供的转印方法制得。

[0088] 本发明实施例有益效果如下:本发明实施例提供的微发光二极管的转印方法,包括:在中转基板形成焊料;控制第一基板的微发光二极管蘸取中转基板的焊料;将蘸取有焊料的微发光二极管通过焊料固定在焊盘上,即,本发明实施例在转印微发光二极管时,先将焊料制作在中转基板上,再使微发光二极管蘸取中转基板上的焊料,最后再将蘸有焊料的微发光二极管固定在焊盘上,相比于现有技术中在转印微发光二极管时,通常需要先通过钢网在焊盘上制作焊料,再将微发光二极管转印到形成有焊料的焊盘上,本发明实施例并不需要通过钢网在焊盘上制作焊料,进而可以改善现有技术通过钢网印刷方式制作微发光二极管时,存在制作较大尺寸的钢网较难,网孔尺寸较难控制,以及容易存现爆灯的问题。

[0089] 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

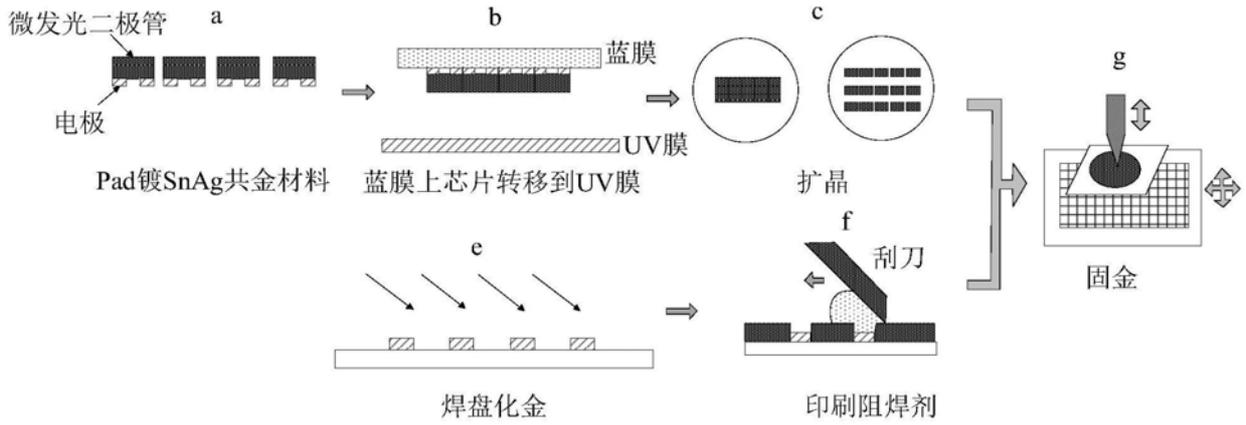


图1

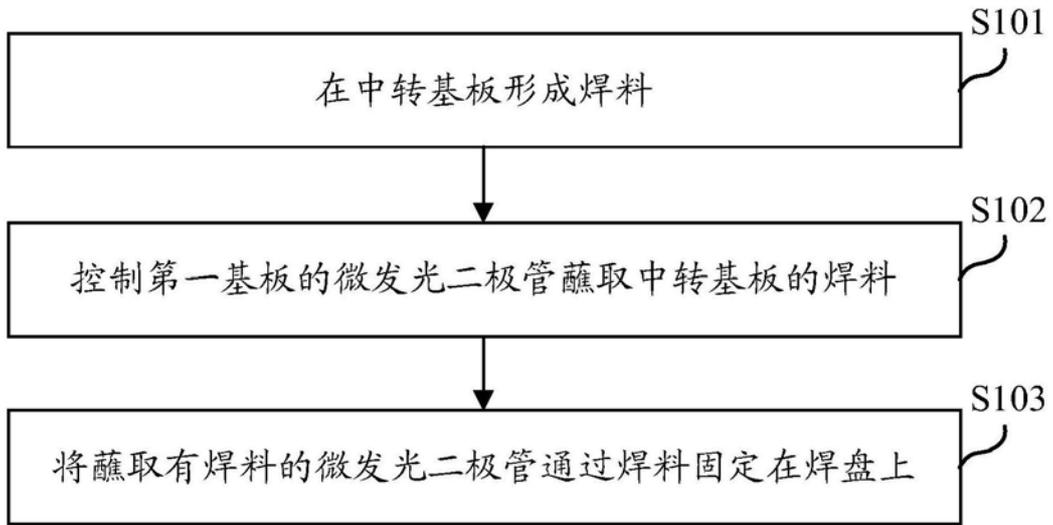


图2

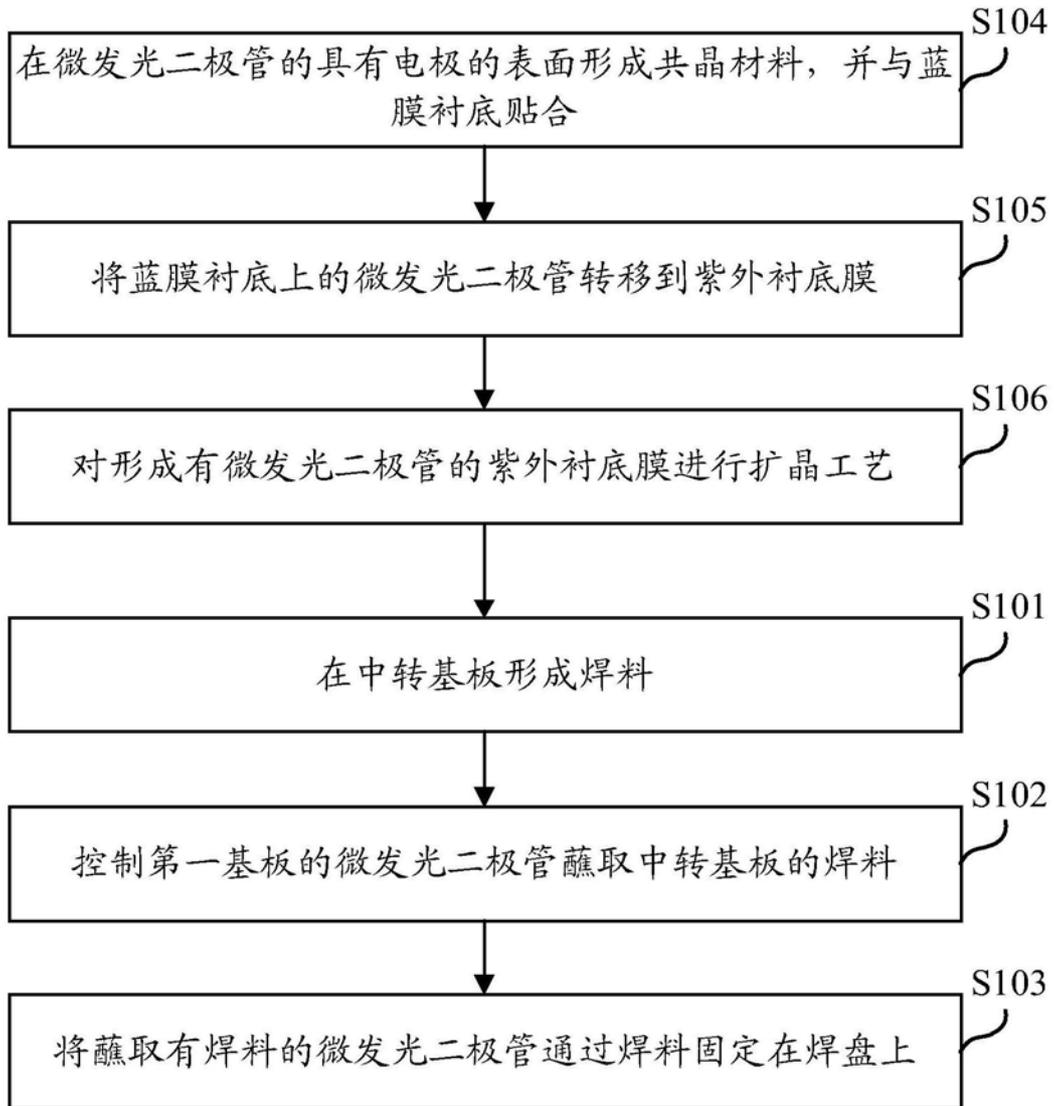


图3

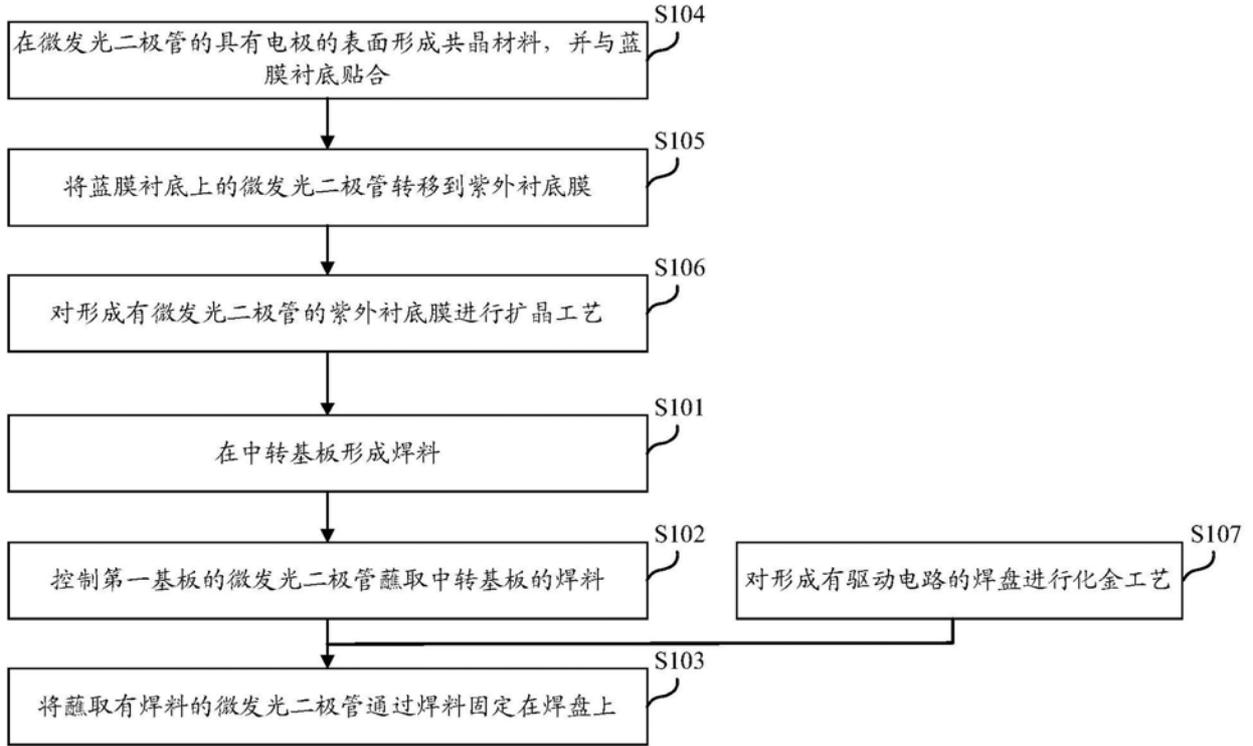


图4

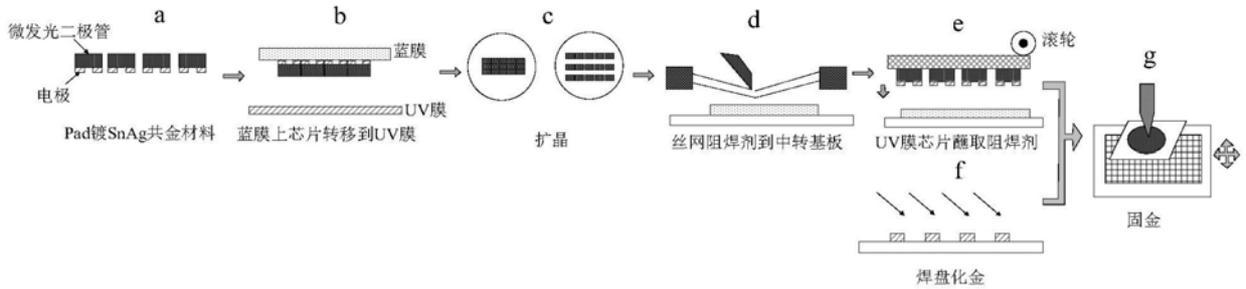


图5

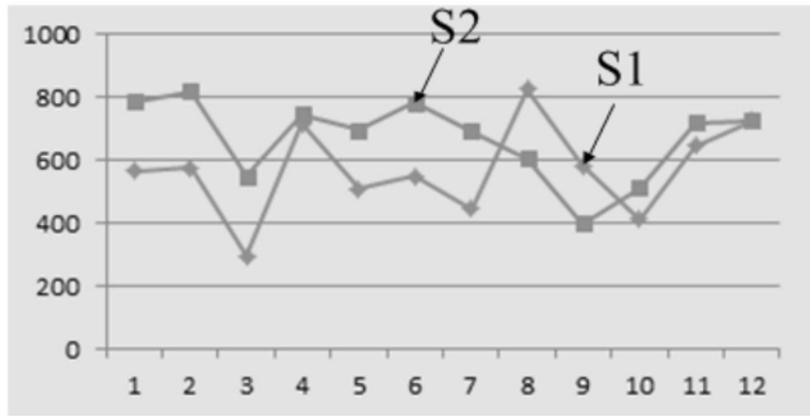


图6

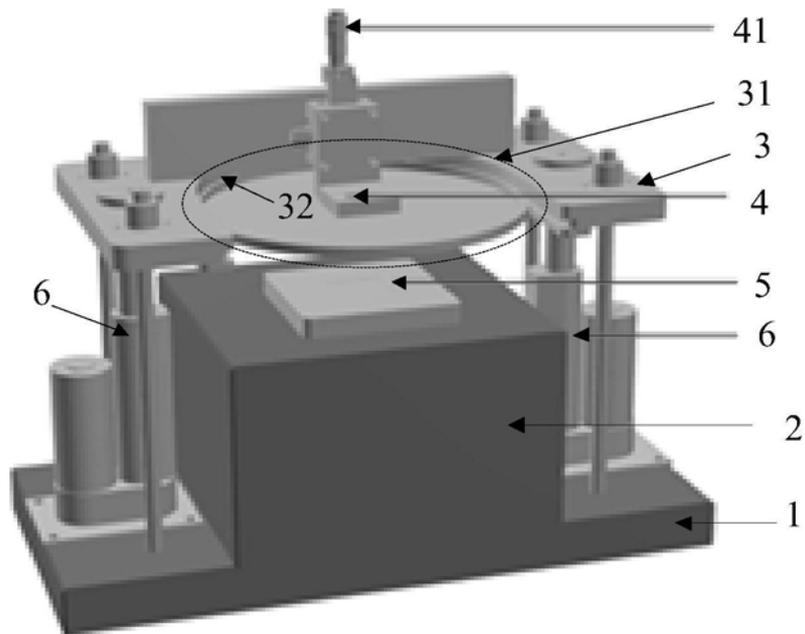


图7

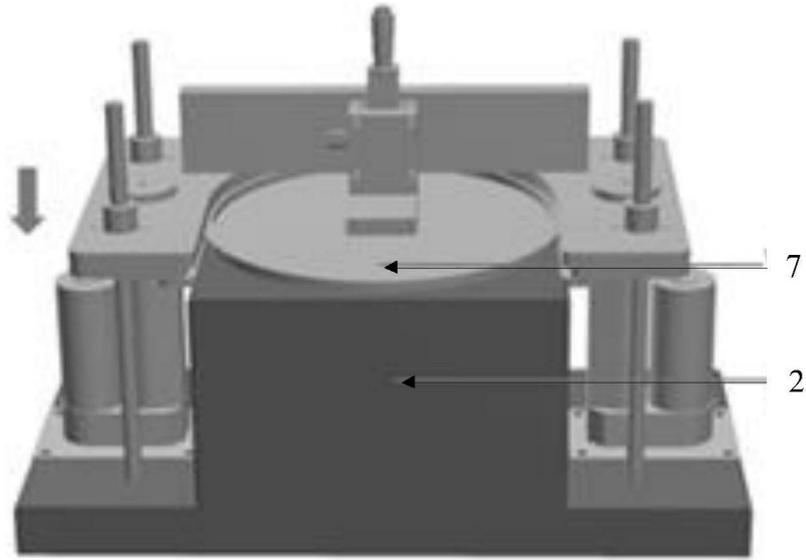


图8

专利名称(译)	一种微发光二极管的转印方法及微发光二极管显示面板		
公开(公告)号	<a href="#">CN111370562A</a>	公开(公告)日	2020-07-03
申请号	CN202010192661.4	申请日	2020-03-18
[标]申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司 北京京东方光电科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司 北京京东方光电科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司 北京京东方光电科技有限公司		
[标]发明人	纪翔宇 董恩凯 李召辉 陈振彰 杨威 李沛 翟明		
发明人	纪翔宇 董恩凯 李召辉 陈振彰 杨威 李沛 翟明		
IPC分类号	H01L33/62 H01L21/683		
代理人(译)	刘源		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a> <a href="#">SIPO</a>		

摘要(译)

本发明公开了一种微发光二极管的转印方法及微发光二极管显示面板，以改善现有技术通过钢网印刷方式制作微发光二极管时，存在制作较大尺寸的钢网较难，网孔尺寸较难控制，印刷偏位，以及容易存现爆灯的问题。所述转印方法，包括：在中转基板形成焊料；控制第一基板的微发光二极管蘸取所述中转基板的所述焊料；将蘸取有所述焊料的所述微发光二极管通过所述焊料固定在焊盘上。

